

无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年6月22日以邮件的方式发出，会议于2022年6月27日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

根据公司发展战略规划以及全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司（以下简称“金兰功率”）的生产经营需要，金兰功率拟将注册资本由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币，新增注册资本4,000万元人民币由上海千凯优电力技术合伙企业（有限合伙）以4,000万元人民币认购，公司放弃优先认购权。

2、审议通过《关于对国硅集成电路技术（无锡）有限公司增资的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

根据公司发展战略规划及实际发展经营的需要，拟以自有资金对国硅集成电

路技术（无锡）有限公司进行增资，注册资本由 315.7895 万元增加至 631.579 万元，增资后公司持股比例由 5%增至 52.5%。增资后国硅集成电路技术（无锡）有限公司纳入公司 2022 年度合并财务报表范围。

国硅集成电路技术（无锡）有限公司是一家专注于车规级智能功率集成电路芯片的设计公司，拥有完整的自主研发体系并掌握多项国内领先的关键核心技术，国内首创四端口单片集成高压自举、自适应高压侧窄脉冲传输、增强型快速电平移位、互导型电容隔离信号传输、超高精度的片上集成双向过流保护等多项功率 IC 芯片核心技术，已形成系列智能功率集成电路芯片，包括：栅极驱动控制 IC 芯片（含 IGBT、硅基 MOSFET 及三代半导体等开关器件的栅极驱动芯片）、电机驱动 IC 芯片（含半桥、H 桥、三相桥）；智能功率 IC 开关（Smart MOS）和功率驱动控制 IC 芯片及模块（DrMOS、IPM 等）系列产品在积极研发中。产品应用市场已涵盖汽车电子、光伏及储能、数据中心和工业控制等领域。目前，国硅的智能功率集成电路芯片已经在光伏逆变、光伏储能、汽车电子和工业控制等市场成功上量。

公司本次对国硅进行增资并实现控股，构建了集成电路领域发力平台，不仅新增了 IC 系列产品本身，还能与公司既有 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、SGT MOSFET、超结 MOSFET 等芯片集成创新，形成智能功率集成产品。在保持公司既有产品技术持续创新、领先的同时，又拓展了智能化、集成化的产品系列，提高了公司产品的整体领先性与综合技术门槛，增强了公司的核心竞争力，进一步满足高端客户的创新需求，为终端客户提供包含 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、SGT MOSFET、超结 MOSFET、智能功率 IC 芯片、智能功率模块等功率半导体芯片的整体解决方案，向打造国内功率半导体第一品牌的目标又前进了一大步。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日